PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

07-128418

(43) Date of publication of application: 19.05, 1995

(51) Int. CI.

G01R 31/36

H02J 7/00

(21) Application number: 05-301302 (71) Applicant: SHINDENGEN ELECTRIC

MFG CO LTD

NIPPON TELEGR &

TELEPH CORP <NTT>

AFUTEI: KK

(22) Date of filing: 05.11.1993 (72) Inventor: KOBAYASHI KIMISADA

SASAKI MASAHIRO TAKANO KAZUO OGATA TSUTOMU KONO MASARU INAGAKI NOBUO

(54) CONSTANT A.C. CHARGE/DISCHARGE CIRCUIT OF BATTERY AND BATTERY TEST DEVICE WITH IT

(57) Abstract:

ற degradation of a battery. deciding mounted microcomputer with an constant battery's a. c. battery PURPOSE: charge/ To provide a internal remaining discharge device impedance by calculating capacity high precision circuit ψ for 9

which constant current discharging circuit 6 current-charges consists charge/discharge CONSTITUTION: charging constant-discharges the battery circuit ofThe circuit 1 battery 10 constant which constant of battery constantcurrent and a a. c.

calculating impedance, battery terminal voltage and peak-to-peak value of constant a.c. charge/discharge circuit of viewed from a that the current flowing into the battery 10 is constant current control signal inputted into each constant current circuit so contained, displays and have flow are remaining capacity and within a mounted microcomputer, contained. battery terminal. In addition, the constant configuration wherein а a.c. signal shaping part for making constant orbattery degradation a.c. is and a employed for constant display decision result a part which detects device a.c. which a.c. as

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 01.08.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3330704

[Date of registration] 19.07.2002

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(A) 蔣公福耕開公(SI) (GI) 前韓國本目(BI)

号各組公康出特替(11)

8月187-128418

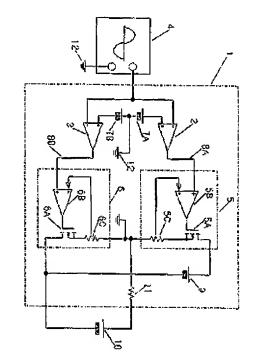
日61月 5 (2661) 李 7 為平 日開公(約)

			ව	00/L	11051
			₹	91/38	COIE
行當示克斯對] 4	月餐壺臺內市	导强服總		(51) Int.CL

(四 3 全) GF 8 端の原象商 浆临床 浆临连霉

000005031	人顯出(17)	韓國士5-301302	与程源出(18)
掛会友執簽工玩即谦			
長1番2目下2而手大図田外子建京東		日 3 共11(8861) 李 3 海平	日瀬出(22)
923100000	人動出(17)		
社会大耕福斯哥苗本日			
長 8 番 I 目下一而幸内 凶田外于潜京吏			
281011834	人離出(17)		
トモヒでが会友耕			
11-8-8 四縣市搜塘漁港京東			
新公 林小	客 閱發(37)		
林柴工元章器 再81番017時南市游戏观正数			
内歇工扩充方			
長衛 共川 小野代	人無外(47)		
>荔5/頁辨攝			

園装錬地リテッパ式が開発は3℃及路回路放洗流露改流交のじそッパ 【森各の阅集】(48)



表面を提供する。 鏡越リモビバな遺語高で行き取衅小客約又置容奇類のリ そっとし出草多れてダーコント語内でそってのよびくさ トマるで海潜すい用金器回路放充漱宮宝流交 【尚目】 【嫁簽】(25) (學更對)

。各で育多民間犹豫の母計派交の各式で蘇 **多素資宝素交も代略るで出業多えてシーコイト , J出射** 金融 Ased or Ased の家語家高交 , 丑露千齢じでゃいい 内イエトマる支護数3065器示奏る支示表を果許取除外 実制なま置容引発も韓国国郊武武国宝流交しテセン、又 。韓国審成表演露宝薫交リそんパパれる熟料のであるな と素質完素交子ある体子器リモヒバ 、幻恋喜るれ恋のり **10そ々パウところをもと母計流交を母計略時用薬室宝み** ならた人の器画添露束のかうなう。 なら気がりよぶる器 回客就添客まるで客就添客家多り(リモッパ 、5 8 約回 室売売室宝さ行多路売款客取310 [リそん)(【規制】

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 バッテリの定電流充電を行なう定電流充 電回路と、前記バッテリより定電流放電を行なう定電流 放電回路への各々の定電流制御信号は、それぞれ定電液 充電回路用誤差増幅回路と定電流放電回路用誤差増幅回 路より信号入力され、前記2つの誤差増幅回路の各々の 基準電源には、ほぼ同一電位で逆極性の2組の電位レベ ルをそれぞれに印加し、前記2つの誤差増幅回路の各々 の比較入力は共通入力線で結び、一組の交流信号を入力 充電される定電流と、前記定電流放電回路を通し該バッ テリから放電される定電流は、前記バッテリ鑵子から見 て交流定電流となるようにした事を特徴とするバッテリ の交流定電流充放電回路。

回路を構成する定電流制御素子、及びバッテリの定電流 放電を行う定電流放電回路を構成する定電流制御素子 は、基々MOSFETを用いた事を特徴とする特許請求 の範囲第1項記載のバッテリの交流定電流充放電回路。 いう) からの交流定電流副御用の交流信号を特許請求の 範囲第1項及び第2項記載の交流定電流充放電回路に与 えることにより、バッテリに交流定電流を流し、前記マ イコンにより、該交流定電流と前記バッテリ鑑子電圧の それぞれの Peak to Peak 値を検出して、前記バッテリ の内部インピーダンスを算出し、該バッテリの残存容置 又は劣化判定を行なう事を特徴とするバッテリ試験装 置。

【請求項2】 バッテリの定電流充電を行う定電流充電

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、バッテリの交流定電流 充放電回路及び、この交流定電流充放電回路を使用して バッテリの残存容置又は劣化判定を行うバッテリ試験装 置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、バッテリの残存容置や劣化判定を 行うバッテリ試験装置としては、容量試験による方法が 一般に行われている。この方法は、電池を実際に放電さ せ容量を測定し、残存容量や劣化判定を行うものであ る。又、この他にバッテリ内の電解液比重を測定する方。40。充電回路から被測定用バッテリに充電される定電流と、 法も行われていた。

100031

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 技術には次の鎌な問題点があった。すなわち

1. バッテリの容置を測定する方法では、長時間バッテ りに比較的大きな電流を流すため、容量試験器全体とし て大きさ、重量の面で作業者にとって取り扱いにくく負 担の大きなものであった。又、測定のために定電流充斂 電する時間は数時間に及び、さらに定電流放電後の回復 の思いものであった。

【①①①4】2、バッテリ内の電解液比重を測定する方 法では、前記バッテリ容量試験器で行う方法に比較し て、作業者への負担や試験時間についてはかなり改善で き優位性は有るものの、密閉型のバッテリの測定は困難 であった。

【0005】従って、上記の如き従来技術の有する問題 点を克服すべく、玄桑明の目的は次の通りである。

1. 作業者にとって負担の大きい、しかも長時間を要す する事により、前記定電流充電回路から前記バッテリに 19 る放電容置の実測や電解液比重の測定を行う字無しにバ ッテリの残存容量又は劣化判定を行う為に、バッテリに 交流定電流を給電し、該定電流とバッテリ鑷子電圧か ち、バッテリ内部インピーダンスを算出可能とするバッ テリ交流定電流充放電回路を提案することを目的とす

【0006】2.交流によるバッテリ内部インビーダン スを測定する為、実数及び虚数分の測定が可能になり、 高精度なバッテリ試験装置を提案する事を目的とする。 【0007】3.前記交流定電流充放電回路を用いてマ 【請求項3】 マイクロコンピュータ(以下マイコンと 20 イコンによりバッテリ内部インピーダンスを算出しバッ テリの残存容量又は劣化判定を行うバッテリ試験装置を 提案することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は上記目 的に対応して、次の様な手段を有している。被測定用バ ッテリの交流定電流充放電回路は、該バッテリの定電流 充電を行うための、例えば定電流制御素子としてMOS FETを用いた定電流充電回路と、該バッテリより定電 撤放電を行なう為の、例えば定電流制御素子としてMO 30 SFETを用いた定電流放電回路により構成され、この 各々の定電流充放電回路に入力される制御信号は、それ ぞれ定電液充電回路用誤差増幅回路と定電流放電回路用 誤差増幅回路より信号入力される。

【① 0 0 9 】そして2つの誤差増幅回路の各々の基準電 圧には、ほぼ同一電位で逆極性の2組の電位レベル (定 電流制御素子のしきい値電圧Vthレベルの印刷用)が、 それぞれに印加され、さらに2つの誤差増幅回路の各々 の比較入力は共通の入力線で結ばれ、一組の任意の周波 数及び弯圧値の交流信号が入力される事により、定弯流 定電流放電回路を通し、被測定用のバッテリから放電さ れる定電流は、バッテリ端子から見て、2つの誤差増幅 回路の各々の比較入力に入力される交流信号により制御 される交流定電流となるように構成された事を特徴とし ている。

【0010】さらに、バッチリ試験装置として、上記の バッテリ交流定電流充放電回路と、マイコン部内に、上 述の交流定電流を定電流制御するための交流信号の成形 部分、バッテリ交流定電流及びバッテリ蝎子電圧の Pea 充電まで考慮すると試験にほぼ1日を要するという効率(50~k to Peak 値(以下1PP、VPP)を検出する検出部

分、さらに検出した「PP、VPPの最大値と最小値の 差分であるそれぞれ△! PP、△VPPよりバッテリ内 部インピーダンス(△VPP/△iPP)を算出する算 **出部分を搭載し、算出した内部インビーダンスを表示す** る表示器により構成された事を特徴としている。

[0011]

【作用】バッチリ交流定電流充放電回路の定電流充放電 制御用の2組の半導体スイッチをそれぞれMOSFET とすることにより、そのゲート駆動は、前段の交流制御 信号により分配された)電圧を印加するだけで良く、回 10 だけ直流重量された交流基準信号となる。 路的にも簡単なものとなり、また駆動電力は微小なもの とする事が可能となる。

【0012】又、バッテリ試験装置は、搭載するマイコ ンによりバッテリ交流定電流及び鑑子電圧の Peak to P eak 値であるIPP,VPPを検出するため、バッテリ 交流定電流充放電回路を動作させる時間はこく短時間で よく、定電液制御素子であるMOSFETの電力損失。 温度上昇はほとんど無視できるため回路構成部品は小さ なものとなり、結果としてバッテリ試験装置を小型なも しそれぞれの差分である△【PP、△VPPによりバッ テリ内部インビーダンスを算出するためバッテリの直流 電圧分は、考慮する必要がない。

[0013]

【実施例】図1に本発明のバッテリ交流定電流充放電回 路の構成を示し、図2に本発明のバッチリ交流定電流充 放電回路を用いたバッテリ試験装置の構成を示す。図 1. 2に於いて、1はバッテリ交流定電流充放電回路、 2 は定電流充電回路誤差増帽器、3 は定電流放電回路用 誤差増幅器、4 は交流信号入力部、5 は定電流充電回 路、5Aは定電流充電回路の定電液制御素子、例えばM OSFET、5Bは定電流充電回路の誤差増幅器、5C は検出抵抗、6は定電流放電回路、6点は定電流放電回 路の定電流制御素子例えばMOSFET、6 Bは定電流 放電回路の誤差増幅器、6Cは検出抵抗、7Aは定電流 充電回路用誤差増幅器の電位レベル、7 Bは定電流放電 回路用誤差増幅器の電位レベル、8A、8Bは定電流制 御信号、9は充電用電源、10は被測定用バッテリ、1 1は交流電流検出抵抗、12はアースレベル、13はマ BはDA変換器、13Cはアナログマルチプレクサ、1 3 Dはサンプルホールド回路、13 EはA D変換器、1 4はフィルタ、15A, 15Bは誤差増幅器、16は表 示器である。

【0014】次に図1,2に基づき本発明のバッテリ交 | 撤定電流充放電回路、バッテリ試験装置の動作。構成に ついて説明する。先ず図1に於いて、バッテリ交流定電 液充放電回路 1 内の定電流充電回路用誤差増幅器 2 、定 電流放電回路用増幅器3の比較入力に交流信号入力部4

定電流充電回路用誤差增幅器2、定電流放電回路用增幅 墨3の基準入力には、定電流充電回路5、定電流放電回 路6の定電液制御素子であるMOSFET5A、6Aの ゲートしきい傾電圧Vthに等しい。 ほぼ同一電位で逆 極性である電位レベル7A.7Bを印触するため、定電 液充電回路用誤差增幅器2. 定弯流放電回路用增幅器3 の出力より定電流充電回路5、定電流放電回路6に入力 される定電流制御信号8A、8Bは、後段の回路が処理 可能な範囲に増幅され、そして電位レベル7A、7B分

【0015】従って、定電流制御信号8A,8Bが定電 添充電回路5の誤差増幅器5B、定電流放電回路6の誤 差増帽器6Bの基準入力に入力されるとMOSFET5 A、6Aのゲートレベルには、自身のしきい値電圧V t bの電位レベル?A、7Bを基準として繊幅を繰り返す。 交流基準信号が入力されることになる。そしてこの交流 基準信号により制御されMOSFET5A, 6Aには交 適差準信号に同期し相似型な交流半波状の電流がMOS FET5Aには充電用電源9より、MOSFET6Aに のとする事が可能となる。また、IPP,VPPを検出 20 は被測定用バッテリ10より治電される。さらに検出抵 抗50、60により誤差増幅器5B、6Bの比較入力に 帰還入力する事により、定電癒充電回路5、定電流放電 回路6の電流は定電流化される。

> 【①①16】そしてこの時の交流電流検出抵抗11を流 れる電流は、バッテリ蝎子からみて交流定電流となり上 述の回路模成でバッテリに交流定電流を給電出来る。

【0017】尚、定電流充電回路5のMOSFET5A は、アースレベル12を基準としたゲート電圧が自身の しきい値電圧Vth以下の交流基準信号では動作でき 30 ず、また定電流放電回路6のMOSFET6Aは、アー スレベル12を基準としたゲート電圧が自身のしきい値 電圧Vth以上では動作できない事は明白である。

【0018】次に図2のバッテリ試験装置の実施例であ るが、マイコン13内部のマイクロブロッセサ(cp u) 13Aの周辺として位置づけられたROM(図示せ ず)に享前搭載した交流信号のデータは、DA変換器! 3 Bにより、図1の交流信号入力部4 に相当するアナロ グ交流信号に変換され、フィルタ14を介し、より精度 の高い交流信号とし、交流定電流制御用の交流信号とし イコン、13Aはマイクロブロッセサ(cpu)、13-49-てバッテリ交流定電流充放電回路1に入力され、これに より上述したようにバッテリ10には交流定電流が給電 される。

【①①19】この際、バッテリ交流定電流は交流電流検 出抵抗11で検出され、又、バッテリ端子電圧は直接着 しくは抵抗分圧回路等で検出され、それぞれ誤差増幅器 15A、15Bで後段の回路が処理可能な範囲に増幅さ れ、マイコン13に内蔵されたアナログマルチプレクサ 13 Cに入力される。続いて後段のサンブルホールド回 第13Dで検出したバッテリ交流定電流値とバッテリ鑑 より交流定電流制御用の交流信号が入力される。そして「50」子電圧値は、交互にサンプリングされ、かつホールドさ

れる。ホールドされたデータは、AD変換器13日によ りデジタル変換されマイクロブロッセサ(cpu)13 Aの周辺として位置づけられたRAM(図示せず)に逐 次保管又は加算され、マイクロプロッセサ(cpu)」 3Aで一括処理される。そしてバッテリ交流定電流及び バッテリ端子翼圧のそれぞれの Peak to Peak 値(iP P. VPP) の差分である△!PP. △VPPを計算し バッテリの内部インピーダンス (AVPP/AIPP) を算出し、LCD等の表示器16に表示することにより バッテリの残存容置又は劣化判定を可能とする。

【0020】との方法による測定では、インピーダンス 2=R+jωL+(1/)ωC)を測定出来るので虚数 部分すなわちバッテリ内部のインダクタンスLやキャバ シタンスCも測定出来る為、より高額度なバッテリ試験 が可能である。但し」は虚数、のは角層波数である。

【0021】尚、対象バッテリの残存容量とバッテリ内 部インピーダンスの相関を示した回帰式をマイクロブロ ッセサ(cou)13A内に享前に絡載し、表示器にバ ッテリの残存容量が表示されるようにすればバッチリの 残存容置又は劣化判定は、より簡明なものとなる事は言 20 丁) うまでもない。

【0022】又、交流定電流制御用の交流信号を一定時 間(例えば10サイクル分)供給し、IPP、VPPを 10回分データサンプリングしてその値を平均化し内部 インピーダンスを算出するようにすればバッテリの残存 容量又は劣化判定の精度がより向上する事は言うまでも

【0023】さらに [PP、 VPPを検出する為。同時 に両者の位相差も測定可能であり内部インピーダンスを 実験部と虚数部に分けて算出、表示できる事も言うまで 30 8A 定電流制御信号 もない。

[0024]

【発明の効果】本発明は、以上説明したように構成され ているため、以下に示すような効果を有する。

(1) バッテリ交流定電流充放電回路は、その定電流制 御素子にMOSFETを使用するためゲート駆動電力は 低減でき、又回路も簡単なものとすることが可能とな

【0025】(2)バッテリ試験装置は、搭載するマイ コンによりバッテリ交流定電流及びバッテリ鑑子電圧の 40 130 サンプルホールド回路 それぞれの Peak to Peak 値であるIPP,VPPを検 出するため、バッテリ交流定電流充放電回路を動作させ る時間はごく短時間(例えば、検出精度を上げるため) ①HZの交流を10回データサンプリングするとしたら 1Sec間)でよく、定電流制御案子であるMOSFE 丁の電力損失。温度上昇はほとんど無視できるため回路。

構成部品は小さなものとなり、結果としてバッテリ試験 装置を小型、軽量なものとする事が可能となる。又、瞬 時にバッテリの残存容置又は劣化判定を行うことが出来

【0026】(3)交流によるバッテリ内部のインビー ダンス測定法である為、バッテリの純紙抗分だけでな く、インダクタンス、キャパシタンス分も測定出来る 為、高精度なバッテリ試験装置が実現出来る。

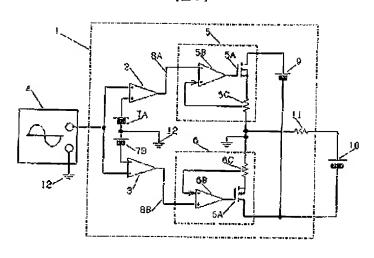
【図面の簡単な説明】

10 【図1】本発明のバッテリ交流定電流充放電回路。 【図2】本発明のバッテリ交流定電流充放電回路を用い たバッテリ試験装置。

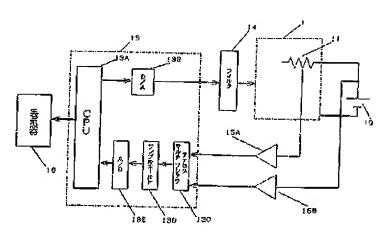
【符号の説明】

- 1 バッテリ交流定電流充放電回路
- 2 定弯流充電回路用誤差增幅器
- 3 定電流放電回路用誤差增幅器
- 4. 交流信号入力部
- 5 定弯滚充電回路
- 5A 定電液充電回路の定電流制御素子(MOSFE
- 5 B 定電流充電回路の誤差増幅器
- 50 検出抵抗
- 6 定弯流放電回路
- 6A 定電流放電回路の定電流制御素子 (MOSFE T)
- 6 B 定電流放電回路の誤差増幅器
- 60 検出抵抗
- 7A 定電流充電回路用誤差増幅器の電位レベル
- 7 B 定電流放電回路用誤差増幅器の電位レベル
- - 8 B 定舊流制御信号
 - 9 充電用電源
 - 10 被測定用バッテリ
 - 11 交流電流検出抵抗
 - 12 アースレベル
 - 13 マイコン
 - 13A マイクロプロッセサ (cou)
 - 13B DA変換器
 - 130 アナログマルチプレクサ
 - - 13E AD変換器
 - 14 フィルタ
 - 16A 誤差増幅器
 - 15B 誤差增幅器
 - 16 表示器

[201]



[図2]



フロントページの続き

(72)発明者 佐々木 正博

埼玉県飯能市南町10香13号 新電元工業株式会社工場內

(72) 発明者 高野 和夫

東京都千代田区内率町一丁目 1 香 6 号 日本電信電話株式会社内

(72)発明者 尾形 努

東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日

本電信電話株式会性内

(72) 発明者 河野 勝

東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

(72) 発明者 稲垣 伸夫

東京都武蔵野市緑町三丁目9番11号 株式

会社アフティ内